

## УСТАНОВКА ГАЗОФАЗНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ ГРУППОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОДЛОЖЕК

### ЭПИКВАР ТМ

**Назначение:** Газофазное осаждение моно- и поликристаллических слоев кремния в широком диапазоне толщин и удельных сопротивлений на монокристаллические подложки кремния или сапфира хлоридным или хлоридно-гидридным методом.



#### Особенности:

- Кварцевый реактор цилиндрического типа с индукционно-радиационным нагревом подложек;
- Испаритель(барботер) кремнийсодержащего вещества;
- Система непрерывной подачи кремнийсодержащего вещества (танк);
- Ручная загрузка/выгрузка пластин;
- Графитовый подложкодержатель под 24 пластины  $\varnothing 100$  мм;
- Микропроцессорная система управления;
- Преобразователь частоты для питания индуктора мощностью до 160 кВт и рабочей частотой 8 кГц;
- Жидкостной скруббер для нейтрализации отработанных продуктов;
- Рабочие газы:  $\text{SiCl}_4$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{HCl}$ ;
- Мощность потребления не более 160 кВт.

